

(19) 中华人民共和国专利局

(51) Int.Cl.⁴

C23C 8/36

C23C 14/38



(12) 实用新型专利申请说明书

(11) CN 86 2 04249 U

CN 86 2 04249 U

(43) 公告日 1987年4月15日

(21) 申请号 86 2 04249

(22) 申请日 86.6.23

(71) 申请人 张弋飞

地址 北京市西城区西四砖塔胡同80号

(72) 设计人 张弋飞

(74) 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利

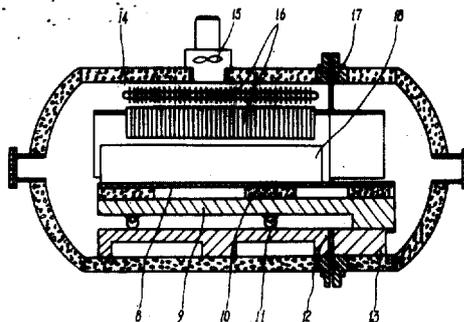
代理部

代理人 包冠乾

(54) 实用新型名称 用于表面材料合成的真空反应室

(57) 摘要

用于表面材料合成的真空反应室装置,它可用米对工件表面进行渗非金属元素或渗金属等操作。该真空室壁不采用通冷却水结构,而采用充填绝热材料层的结构,反应室内设有热交换器,风扇及灭弧电阻。反应室为分体式结构,由固定室和活动室组成。活动室可以沿导轨运动而与固定室分开或合紧。该真空反应室热能损失小、升温快。冷却时能加快冷却速度。提高工作效率,并且易于进行装卸工件的操作以及易于进行检修和保养。



北京市期刊登记证第1407号